



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107293573 A

(43)申请公布日 2017. 10. 24

(21)申请号 201710546181.1

(22)申请日 2017.07.06

(71)申请人 京东方科技集团股份有限公司

地址 100015 北京市朝阳区酒仙桥路10号

申请人 合肥鑫晟光电科技有限公司

(72)发明人 许名宏

(74)专利代理机构 北京天昊联合知识产权代理有限公司 11112

代理人 姜春咸 陈源

(51)Int.Cl.

H01L 27/32(2006.01)

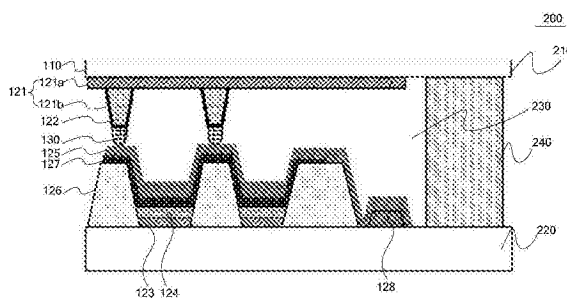
权利要求书1页 说明书7页 附图1页

(54)发明名称

OLED基板和OLED显示装置

(57)摘要

本发明公开了一种OLED基板和OLED显示装置, OLED基板包括衬底基板以及形成在衬底基板上的功能元件层, 功能元件层包括位于该功能元件层表层的导电层, OLED基板还包括形成在衬底基板上的至少一个连接件, 连接件能够导电, 连接件设置在导电层上, 当连接件所处的温度大于或等于预设封装温度时, 连接件为熔融态, 当连接件所处的温度小于预设封装温度时, 连接件为固态。本发明的OLED基板, 其中的连接件所处的温度大于或等于预设封装温度时能够形成熔融态接点, 因此, 当利用该基板与另一个基板封装形成OLED显示装置时, 也即在进行封装时, 能够使得两个基板的连接点位置保持良好地欧姆接触, 当封装完成以后, 能够有效提高所形成的OLED显示装置的显示性能。



1. 一种OLED基板,所述OLED基板包括衬底基板以及形成在所述衬底基板上的功能元件层,所述功能元件层包括位于该功能元件层表层的导电层,其特征在于,所述OLED基板还包括形成在所述衬底基板上的至少一个连接件,所述连接件能够导电,所述连接件设置在所述导电层上,当所述连接件所处的温度大于或等于预设封装温度时,所述连接件为熔融态,当所述连接件所处的温度小于所述预设封装温度时,所述连接件为固态。

2. 根据权利要求1所述的OLED基板,其特征在于,所述导电层为网格状,且所述导电层与像素单元中的子像素的边界重叠,所述功能元件层还包括多个支撑物,所述支撑物设置在所述衬底基板和所述导电层之间,且所述导电层覆盖所述支撑物,所述连接件设置在所述支撑物的背离所述衬底基板的端部。

3. 根据权利要求1所述的OLED基板,其特征在于,所述功能元件层包括依次形成在所述衬底基板上的阳极层、发光层和阴极层,所述导电层包括所述阴极层,所述功能元件层还包括像素界定件,所述像素界定件将所述功能元件层划分为多个像素单元,所述连接件位于所述像素界定件上方。

4. 根据权利要求3所述的OLED基板,其特征在于,所述功能元件层还包括修饰层,所述修饰层位于所述阴极层的下方,并与所述阴极层接触。

5. 根据权利要求1至4任意一项所述的OLED基板,其特征在于,所述连接件的材料包括镓基合金或铟、锡、铋和锌中任意两种或以上的合金。

6. 一种OLED显示装置,所述OLED显示装置包括封装盖板和OLED显示基板,其特征在于,所述封装盖板上设置有导电层,所述OLED显示装置还包括至少一个连接件,所述连接件位于所述导电层和所述OLED显示基板的阴极层之间,所述连接件能够导电,所述连接件分别电连接所述导电层和所述OLED显示基板的阴极层,以使得所述导电层与所述OLED显示基板的阴极层并联;当所述连接件所处的温度大于或等于预设封装温度时,所述连接件为熔融态,当所述连接件所处的温度小于所述预设封装温度时,所述连接件为固态。

7. 根据权利要求6所述的OLED显示装置,其特征在于,所述导电层为网格状,且所述导电层与像素单元中的子像素的边界重叠。

8. 根据权利要求6所述的OLED显示装置,其特征在于,所述OLED显示基板还包括像素界定件,所述像素界定件将所述OLED显示基板划分为多个像素单元,所述连接件位于所述像素界定件上方。

9. 根据权利要求6至8任意一项所述的OLED显示装置,其特征在于,所述封装盖板的朝向所述OLED显示基板的一侧还设置有多个支撑物,所述导电层覆盖所述支撑物,所述连接件设置在所述支撑物的背离所述封装盖板的端部。

10. 根据权利要求6至8任意一项所述的OLED显示装置,其特征在于,所述OLED显示基板上还设置有修饰层,所述修饰层位于所述阴极层的下方,并与所述阴极层接触。

OLED基板和OLED显示装置

技术领域

[0001] 本发明涉及显示技术领域,具体涉及一种OLED基板和一种OLED显示装置。

背景技术

[0002] 一般的,打印有机发光二极管(Printed OLED)因具有高材料利用率、高效率等特点,以及应用于显示器不需精细金属掩膜(Fine Metal Mask,FMM)或其他复杂图案化工艺等特性,易于大面积制备及全色显示等优点。因此,打印有机发光二极管具有广阔的应用前景,尤其适合应用于大尺寸显示器中,即大尺寸的OLED显示装置。

[0003] 这其中,为了增加OLED显示装置的开口率等,往往将其设计为顶发射型。然而,传统的顶发射型OLED显示装置,其中的阴极的阻抗较大,而OLED显示装置又为电流驱动的器件,工作过程中的电流流经阻抗较大的阴极将造成较大的压降,也就是所谓的1R压降(1R-Drop)。

[0004] 因此,如何解决OLED显示装置的1R压降成为本领域亟待解决的技术问题。

发明内容

[0005] 本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一,提出了一种OLED基板和一种OLED显示装置。

[0006] 为了实现上述目的,本发明的第一方面,提供一种OLED基板,所述OLED基板包括衬底基板以及形成在所述衬底基板上的功能元件层,所述功能元件层包括位于该功能元件层表层的导电层,所述OLED基板还包括形成在所述衬底基板上的至少一个连接件,所述连接件能够导电,所述连接件设置在所述导电层上,当所述连接件所处的温度大于或等于预设封装温度时,所述连接件为熔融态,当所述连接件所处的温度小于所述预设封装温度时,所述连接件为固态。

[0007] 优选地,所述导电层为网格状,且所述导电层与像素单元中的子像素的边界重叠,所述功能元件层还包括多个支撑物,所述支撑物设置在所述衬底基板和所述导电层之间,且所述导电层覆盖所述支撑物,所述连接件设置在所述支撑物的背离所述衬底基板的端部。

[0008] 优选地,所述功能元件层包括依次形成在所述衬底基板上的阳极层、发光层和阴极层,所述导电层包括所述阴极层,所述功能元件层还包括像素界定件,所述像素界定件将所述功能元件层划分为多个像素单元,所述连接件位于所述像素界定件上方。

[0009] 优选地,所述功能元件层还包括修饰层,所述修饰层位于所述阴极层的下方,并与所述阴极层接触。

[0010] 优选地,所述连接件的材料包括镓基合金或铟、锡、铋和锌中任意两种或以上的合金。

[0011] 本发明的第二方面,提供一种OLED显示装置,所述OLED显示装置包括封装盖板和OLED显示基板,所述封装盖板上设置有导电层,所述OLED显示装置还包括至少一个连接件,

所述连接件位于所述导电层和所述OLED显示基板的阴极之间,所述连接件能够导电,所述连接件分别电连接所述导电层和所述OLED显示基板的阴极层,以使得所述导电层与所述OLED显示基板的阴极层并联;当所述连接件所处的温度大于或等于预设封装温度时,所述连接件为熔融态,当所述连接件所处的温度小于所述预设封装温度时,所述连接件为固态。

[0012] 优选地,所述导电层为网格状,且所述导电层与像素单元中的子像素的边界重叠。

[0013] 优选地,所述OLED显示基板还包括像素界定件,所述像素界定件将所述OLED显示基板划分为多个像素单元,所述连接件位于所述像素界定件上方。

[0014] 优选地,所述封装盖板的朝向所述OLED显示基板的一侧还设置有多个支撑物,所述导电层覆盖所述支撑物,所述连接件设置在所述支撑物的背离所述封装盖板的端部。

[0015] 优选地,所述OLED显示基板上还设置有修饰层,所述修饰层位于所述阴极层的下方,并与所述阴极层接触。

[0016] 本发明的OLED基板,设置有导电层和连接件,且该连接件所处的温度大于或等于预设封装温度时能够形成熔融态接点,因此,当利用该基板与另一个基板封装形成OLED显示装置时,也即在进行封装时,所形成的熔融态接点能够使得两个基板的连接点位置保持良好地欧姆接触,当封装完成以后,能够有效提高所形成的OLED显示装置的显示性能。同时,呈熔融态的连接件,在封装压合过程中,还能够有效保护两个基板上的膜层结构,提高产品良率。

[0017] 本发明的OLED显示装置,在封装盖板和OLED显示基板之间设置有上述的连接件,且该连接件所处的温度大于或等于预设封装温度时能够形成熔融态接点,因此,当将封装盖板和OLED显示基板进行封装以形成该OLED显示装置时,所形成的熔融态接点能够使得封装盖板上的导电层与OLED显示基板的阴极层保持良好地欧姆接触,当封装完成以后,能够有效提高所形成的OLED显示装置的显示性能。同时,呈熔融态的连接件,在封装压合过程中,还能够有效保护两个基板上的膜层结构,提高产品良率。

附图说明

[0018] 附图是用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本发明,但并不构成对本发明的限制。在附图中:

[0019] 图1为本发明中OLED显示装置的结构示意图。

[0020] 附图标记说明

[0021] 110:衬底基板;

[0022] 121:导电层;

[0023] 121a:辅助导电层;

[0024] 121b:连接导电层;

[0025] 122:支撑物;

[0026] 123:阳极层;

[0027] 124:发光层;

[0028] 125:阴极层;

[0029] 126:像素界定件;

[0030] 127:修饰层;

- [0031] 128:直流输入接口;
- [0032] 130:连接件;
- [0033] 200:OLED显示装置;
- [0034] 210:封装盖板;
- [0035] 220:OLED显示基板;
- [0036] 230:填充物;
- [0037] 240:封框胶层。

具体实施方式

[0038] 以下结合附图对本发明的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明,并不用于限制本发明。

[0039] 参考图1,本发明的第一方面,涉及一种OLED基板。该OLED基板包括衬底基板110以及形成在衬底基板110上的功能元件层。该功能元件层包括位于该功能元件层表层的导电层121。

[0040] 其中,上述OLED基板还包括形成在衬底基板110上的至少一个连接件130,该连接件130能够导电,也就是说,该连接件130由导电材料制成或者是在连接件130的表面上涂覆有导电材料等。

[0041] 上述连接件130设置在上述导电层121上,也就是说,该连接件130与导电层121电连接。当连接件130所处的温度大于或等于预设封装温度时,该连接件130为熔融态,当连接件130所处的温度低于预设封装温度时,该连接件130为固态。也就是说,连接件130随着所处的温度的变化,其可以在固态和熔融态之间转化。

[0042] 为了便于说明,以该OLED基板为封装盖板210为例进行说明。在封装盖板210的封装制程中,控制封装制程的温度,保证该封装制程所处的温度大于或等于预设封装温度,以使得连接件130呈熔融态(也就是说,相当于连接件130变软或者熔化,形成接点)。因此,在利用外力将封装盖板210和OLED显示基板220压合封装时,连接件130能够更好地与封装盖板210上的导电层121以及与所述OLED显示基板220上的阴极层125电连接,当封装完成以后,连接件130重新由熔融态变为固态,依然与封装盖板210上的导电层121和OLED显示基板220的阴极层125保持良好地电性接触,也即保持良好地欧姆接触。也就是说,连接件130能够更好地搭接在OLED显示基板220的阴极层125上,实现与OLED显示基板220上的阴极层125并联,从而能够降低OLED显示基板220的阴极层125的电阻,进而能够降低OLED显示基板220上的1R压降,提高封装所形成的OLED显示装置200的显示性能。

[0043] 需要说明的是,该OLED基板也可以为OLED显示基板220,在该OLED基板为OLED显示基板220时,上述的导电层121应当为OLED显示基板220的阴极层125,同样的,设置有上述的连接件130,在将该结构的OLED显示基板220与封装盖板210在预设封装温度下进行封装时,该连接件130可以将OLED显示基板220的阴极层125与封装盖板220上的导电层121电连接,从而降低OLED显示基板220的阴极层125的电阻,进而能够降低OLED显示基板220上的1R压降,提高封装所形成的OLED显示装置200的显示性能。

[0044] 进一步需要说明的是,至于具体的预设封装温度,可以根据实际需要进行确定,在此不作限定。

[0045] 仍需要说明的是,对于连接件130的具体材料并没有作出限定,但是,该连接件130应当能够满足在其所处的温度大于或等于预设封装温度时,其能够由固态变为熔融态,在低于预设封装温度时,能够从熔融态重新变为固态即可。

[0046] 本实施例结构的OLED基板,设置有导电层121和连接件130,且该连接件130所处的温度大于或等于预设封装温度时能够形成熔融态接点,因此,当利用该基板与另一个基板封装形成OLED显示装置200时,也即在进行封装时,所形成的熔融态接点能够使得两个基板的连接点位置保持良好地欧姆接触,当封装完成以后,能够有效提高所形成的OLED显示装置200的显示性能。同时,呈熔融态的连接件130,在封装压合过程中,还能够有效保护两个基板上的膜层结构,提高产品良率。

[0047] 优选地,上述导电层121为网格状,且导电层121与像素单元(图中并未示出)中的子像素(图中并未示出)的边界重叠。

[0048] 也就是说,该OLED基板为封装盖板210,其中所设置的导电层121为网格状,并且网格状的导电层121与子像素的边界重叠。因此,该导电层121并不会阻挡像素单元中子像素所发出的光线,也就是说,可以提高子像素的透光性,不影响利用该OLED基板所形成的OLED显示装置200的显示性能。

[0049] 优选地,如图1所示,上述功能元件层还包括多个支撑物122。其中,支撑物122设置在衬底基板110和导电层121之间,且导电层121覆盖支撑物122,上述连接件130设置在支撑物122的背离衬底基板110的端部。

[0050] 本实施例结构的OLED基板,为封装盖板210,封装盖板210上所设置的支撑物122,在利用该结构的封装盖板210与OLED显示基板220进行封装形成OLED显示装置200时,所设置的支撑物122能够有效支撑所形成的OLED显示装置200的强度。

[0051] 需要说明的是,对于多个支撑物122的设置位置并没有限定,为了不影响所形成的OLED显示装置200的发光性能,优选地,该多个支撑物122的位置位于OLED显示基板220的子像素的边界处,处于该位置处的支撑物122,不会阻挡子像素发出的光线,从而不会影响所形成的OLED显示装置200的显示性能。

[0052] 具体地,如图1所示,上述导电层121包括辅助导电层121a和连接导电层121b,其中,辅助电极层121a可以位于衬底基板110和多个支撑物122之间,也就是说,可以在衬底基板110上利用黄光制程或其他工艺方式制作形成辅助电极层121a(该辅助电极层121a可以呈网格状),之后在该辅助电极层121a的背离衬底基板110的一侧形成多个支撑物122,之后,在多个支撑物122的表面,覆盖一层导电膜(例如,为了易于搭接,该导电膜可以由ITO材料制成)形成连接导电层121b,这样,上述的连接件130容易搭接在该连接导电层121b上,可以通过该连接导电层121b与辅助电极层121a电连接。

[0053] 本实施例结构的OLED基板,其中的导电层121包括位于支撑物122和衬底基板110之间的辅助导电层121a以及包覆支撑物122外侧的连接导电层121b,可以使得该结构的OLED基板的制作工艺更加简单,降低该OLED基板的制作成本。同时,在将该结构的OLED基板进行封装压合形成OLED显示装置200时,其中的连接件130可以与连接导电层121b以及OLED显示基板220的阴极层125更好地搭接,保持良好地欧姆接触,避免造成连接件130与OLED显示基板220的阴极层125或者连接导电层121b出现间隙,造成接触不良等现象。

[0054] 优选地,上述功能元件层包括依次形成在衬底基板110上的阳极层123、发光层124

和阴极层125。其中,上述导电层121包括阴极层125。也就是说,该结构的OLED基板为OLED显示基板220,该导电层121为该OLED显示基板220的阴极层125,上述连接件130直接设置在该OLED显示基板220上。这样,在预设封装温度下进行封装时,连接件130变为熔融态,当封装完成以后,可以使得该OLED显示基板220上的阴极层125通过连接件130更好地与封装盖板210上的导电层121电连接,降低阴极层125的电阻,提高其驱动电流,从而改善显示性能。

[0055] 优选地,上述功能元件层还包括像素界定件126。其中,该像素界定件126将功能元件层划分为多个像素单元(图中并未示出),上述连接件130位于像素界定件126上方。也就是说,连接件130的位置与像素界定件126的位置相对应,由于像素界定件126将功能元件层划分出了多个像素单元,因此,该连接件130的位置显然处于像素单元之间的间隔区,也即处于非发光区域的位置,也即处于非开口区,因此,不影响所形成的OLED显示装置200的发光性能。

[0056] 优选地,上述功能元件层还包括修饰层127,该修饰层127位于上述阴极层125的下方,并与该阴极层125接触。

[0057] 该结构的OLED显示基板200,其中的发光层124可以采用打印方法制作形成。具体地,发光层124可以采用子像素并排SBS(Side By Side)的架构。

[0058] 首先,利用打印方法在像素界定件126之间的区域打印有机材料并干燥成膜,例如,可以先打印空穴注入层和空穴传输层,之后分别打印R、G、B发光层,以形成上述发光层124。

[0059] 其次,为了使得阴极层125有较好的注入特性,优选地,顶发射OLED需再利用热蒸镀方式镀上注入修饰层127,该修饰层127的厚度约为10-20nm,修饰层127可以选用有机半导体材料制作形成。

[0060] 由于阴极层125有较高的功函数(4-5.5eV),有机打印材料有较低未占有电子的能级最低的轨道(LUMO,Lowest Unoccupied Molecular Orbital),两者之间有较大的注入能障。修饰层127可以选用LUMO介于阴极层与发光层之间的材料作为注入的桥接,因此,能够使得阴极层125具有较好的注入特性。

[0061] 最后,再以溅镀制作透明氧化物(如IZO)作为阴极层125,其厚度约为70-300nm。当然,阴极层125也可以先采用热蒸镀方式制作形成的薄金属电极(金属电极的材料,例如,可以为镁、银或镁银合金等),该薄金属电极的厚度可以为1-30nm,最后可以根据实际需要(例如,根据导电性能),再以溅镀方式在薄金属电极上镀上上述的透明氧化物(如IZO)。

[0062] 优选地,上述连接件130的材料包括镓基合金或铟、锡、铋和锌中任意两种或以上的合金。

[0063] 选用由镓基合金或铟、锡、铋和锌中任意两种或以上的合金材料制作所形成的连接件130,该种材料的熔点较低,约为60-℃。同时,在OLED基板的封装制程中,预设封装温度一般也为60-℃,也就是说,连接件130的熔点与预设封装温度相匹配。因此,该结构的连接件130,能够简化封装制程,还能够有效保护位于OLED基板上的各膜层结构。同时,该种材料的连接件130,可以利用具有加热功能的喷墨打印喷头或其他方式的点胶方法打在封装盖板210的连接导电层121b上,为了避免金属氧化,打印的过程可以在氮气下进行并于在打印后调整预烤条件使得连接件130的轮廓达到较好的外形,并驱赶有机溶剂等影响直流输入接口128的杂质,最终可以控制连接件130的高度为1μm或0.1-15μm之间。

[0064] 对于直流输入接口128的位置并没有作出限定,例如,该直流输入接口128设置在OLED显示基板220上,如图1所示,OLED显示基板220的阴极层125可以朝向该直流输入接口128延伸,以便将直流输入接口128覆盖,该直流输入接口128也可以采用热蒸镀方式制作形成。

[0065] 本发明的第二方面,涉及一种OLED显示装置200。该OLED显示装置200包括封装盖板210和OLED显示基板220,封装盖板220上设置有导电层121。其中,该OLED显示装置200还包括至少一个连接件130,该连接件130位于导电层121和OLED显示基板220的阴极层125之间。

[0066] 其中,上述连接件130能够导电,且该连接件130分别电连接导电层121和OLED显示基板220的阴极层125,以使得导电层121与OLED显示基板220的阴极层125并联。并且,当连接件130所处的温度大于或等于预设封装温度时,连接件130为熔融态,当连接件130所处的温度小于预设封装温度时,连接件130为固态。

[0067] 具体地,在该OLED显示装置200的封装制程中,控制封装制程的温度,保证该封装制程所处的温度大于或等于预设封装温度,以使得连接件130呈熔融态(也就是说,相当于连接件130变软或者熔化,形成接点)。因此,在利用外力将封装盖板210和OLED显示基板220压合封装时,连接件130能够更好地与封装盖板210上的导电层121以及OLED显示基板220上的阴极层125电连接,当封装完成以后,连接件130重新由熔融态变为固态,依然与封装盖板210上的导电层121和OLED显示基板220的阴极层125保持良好地电性接触,也即保持良好地欧姆接触。也就是说,连接件130能够更好地搭接在OLED显示基板220的阴极层125上,实现与OLED显示基板220上的阴极层125并联,从而降低OLED显示基板220的阴极层125的电阻,进而能够降低OLED显示基板220上的1R压降,提高OLED显示装置200的显示性能。

[0068] 本实施例结构的OLED显示装置200,在封装盖板210和OLED显示基板220之间设置有上述的连接件130,且该连接件130在达到预设封装温度下能够形成熔融态接点,因此,当将封装盖板210和OLED显示基板220进行封装以形成该OLED显示装置200时,所形成的熔融态接点能够使得封装盖板210上的导电层121与OLED显示基板220的阴极层125保持良好地欧姆接触,当封装完成以后,能够有效提高所形成的OLED显示装置200的显示性能。同时,呈熔融态的连接件130,在封装压合过程中,还能够有效保护两个基板上的膜层结构,提高产品良率。

[0069] 优选地,上述导电层121为网格状,且导电层121与像素单元中的子像素的边界重叠。

[0070] 本实施例结构的OLED显示装置200,其中所设置的导电层121为网格状,并且网格状的导电层121与子像素的边界重叠。因此,该导电层121并不会阻挡像素单元中子像素所发出的光线,也就是说,可以提高子像素的透光性,不影响OLED显示装置200的显示性能。

[0071] 优选地,上述OLED显示基板220还包括像素界定件126。其中,该像素界定件126将OLED显示基板220划分为多个像素单元,上述连接件130位于像素界定件126上方。

[0072] 也就是说,连接件130的位置与像素界定件126的位置相对应,由于像素界定件126将OLED显示基板220划分出了多个像素单元,因此,该连接件130的位置显然处于像素单元之间的间隔区,也即处于非发光区域的位置,也即处于非开口区,因此,不影响该OLED显示装置200的发光性能。

[0073] 优选地,为了有效支撑OLED显示装置200的强度,上述封装盖板210的朝向OLED显示基板220的一侧还设置有多个支撑物122。其中,导电层121覆盖支撑物122,连接件130设置在支撑物122的背离封装盖板210的端部。

[0074] 优选地,如图1所示,为了使得阴极层125有较好的注入特性,OLED显示基板220还包括修饰层127,修饰层127位于阴极层125的下方,并与该阴极层125接触。该修饰层127的厚度约为10-20nm,修饰层127可以选用有机半导体材料制作形成。

[0075] 如图1所示,为了有效固定封装盖板210和OLED显示基板220,上述OLED显示装置200,还可以包括位于周边区的封框胶层240以及位于显示区的填充物230,其中,封框胶层240可以采用有机聚合物材料形成,填充物230可以采用透明有机聚合物材料制作形成。

[0076] 可以理解的是,以上实施方式仅仅是为了说明本发明的原理而采用的示例性实施方式,然而本发明并不局限于此。对于本领域内的普通技术人员而言,在不脱离本发明的精神和实质的情况下,可以做出各种变型和改进,这些变型和改进也视为本发明的保护范围。

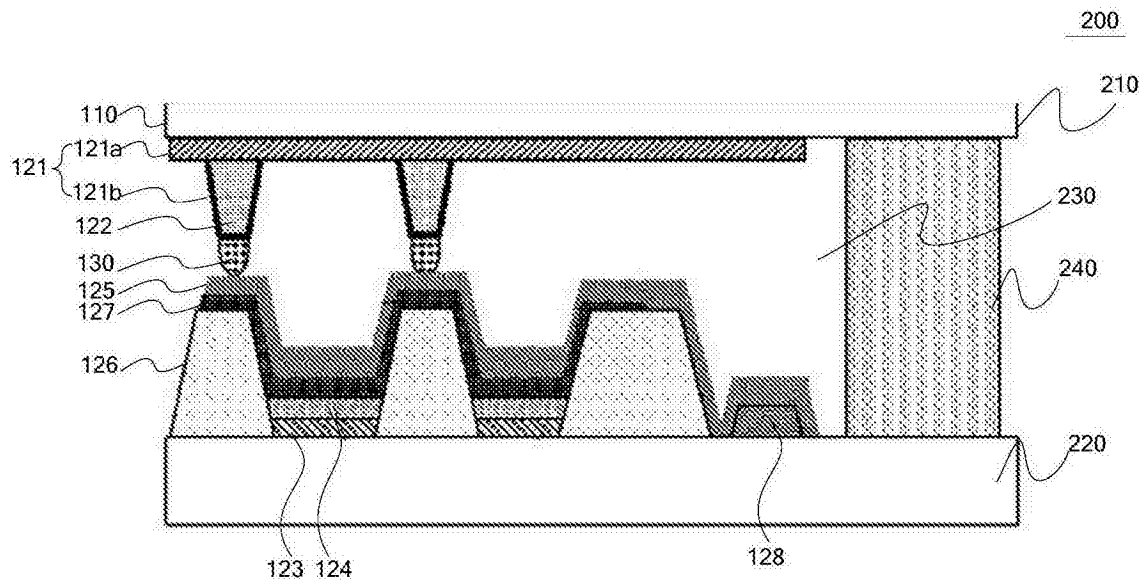


图1

专利名称(译)	OLED基板和OLED显示装置		
公开(公告)号	CN107293573A	公开(公告)日	2017-10-24
申请号	CN201710546181.1	申请日	2017-07-06
[标]申请(专利权)人(译)	京东方科技集团股份有限公司 合肥鑫晟光电科技有限公司		
申请(专利权)人(译)	京东方科技集团股份有限公司 合肥鑫晟光电科技有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	京东方科技集团股份有限公司 合肥鑫晟光电科技有限公司		
[标]发明人	许名宏		
发明人	许名宏		
IPC分类号	H01L27/32		
CPC分类号	H01L27/3279		
代理人(译)	陈源		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本发明公开了一种OLED基板和OLED显示装置，OLED基板包括衬底基板以及形成在衬底基板上的功能元件层，功能元件层包括位于该功能元件层表层的导电层，OLED基板还包括形成在衬底基板上的至少一个连接件，连接件能够导电，连接件设置在导电层上，当连接件所处的温度大于或等于预设封装温度时，连接件为熔融态，当连接件所处的温度小于预设封装温度时，连接件为固态。本发明的OLED基板，其中的连接件所处的温度大于或等于预设封装温度时能够形成熔融态接点，因此，当利用该基板与另一个基板封装形成OLED显示装置时，也即在进行封装时，能够使得两个基板的连接点位置保持良好地欧姆接触，当封装完成以后，能够有效提高所形成的OLED显示装置的显示性能。

